# 2012级大学物理2期末试题参考答案(信二学习部整理

### 一、填空题(共40分)

- 2. 4
- (3分)
- 3. 0.4 H
- (3分)

5. 
$$\frac{\varepsilon_{n}-1}{\varepsilon_{n}+\varepsilon_{n}}\frac{Q}{2\pi R^{2}}$$
 (2 ft)  $\frac{\varepsilon_{n}-1}{\varepsilon_{n}+\varepsilon_{n}}\frac{Q}{2\pi R^{2}}$  (2 ft)

$$\frac{\varepsilon_{r2}-1}{\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2}}\frac{Q}{2\pi R^2}$$

(2分)

7.  $\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{2}} v \varepsilon$ 

8. 1.48×10<sup>10</sup>m; (2分) 50.27s (2分)

9. 6.46×10<sup>-30</sup>kg: (2分) 5.8×10<sup>-13</sup>J (2分) 10. 2.5V

(2分)

约 4.0×1014 Hz

(2分)

2.55eV (2分) 11.

4 (2分)

### 二、选择题(每题3分, 共15分)

CBCAC

#### 三、计算题(共45分)

1. 解: (1)分析可知, 电场分布具有轴对称性, 取与带电图柱体同轴, 截匣半 径为r, 长为1的圆柱面为高斯面。由高斯定理,

$$\oint_{S} E \cdot dS = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum q_{g_{0}} \quad \text{if} \quad E \cdot 2\pi \sigma l = \frac{q_{\infty}}{\varepsilon_{0}}$$
(3 \(\frac{1}{2}\))

当 $r \le R$ 时, $q_{\mathfrak{H}} = \pi r^2 l \rho$ , $E_{\mathfrak{H}} = \frac{\rho}{2\varepsilon_*} r$ ;

当
$$r \ge R$$
时, $q_n = \pi R^2 l_p$ , $E_n = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_n r}$ 。 (4分)

(2) 由电势的定义,得

$$\varphi_r = \int_r^0 E_{\phi_r} dr = \int_r^0 \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r dr = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0} r^2;$$
 (3 \(\frac{4}{2}\))

## 2012级大学物理2期末试题参考答案(信二学习部整理

 解: 设 i 为载流平面的面电流密度。 B 为无限大载 流平面产生的磁场, B。为均匀磁场的磁感强度,作安

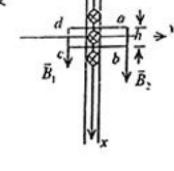
培环路 abcda,由安培环路定理得

$$\oint \overline{B} \cdot d\overline{I} = \mu_0 i h$$

$$Bh + Bh = \mu_0 i h$$

$$\therefore B = \frac{1}{2} \mu_0 i$$

$$B_1 = B_0 - B, B_2 = B_0 + B$$
(3 \(\frac{1}{2}\))



$$B_0 = \frac{1}{2}(B_1 + B_2), \quad B = \frac{1}{2}(B_2 - B_1)$$

$$i = (B_2 - B_1)/\mu_0 \tag{3.5}$$

在无限大平面上沿z轴方向上取长 dz, 沿x 轴方向取宽 dx, 则其面积为 dS = dzdx, 面元所受的安培力为:

$$\bar{F} = i dx dz B_0(-\bar{j}) = i dS B_0(-\bar{j})$$
单位面积所受的力 
$$\frac{\bar{F}}{dS} = i B_0(-\bar{j}) = -\frac{B_1^2 - B_1^2}{2\mu_0} \bar{j}$$
 (4分)

或由载流平面单位面积所受磁场力公式  $\vec{F} = \vec{i} \times \vec{B}$ 。

由于电流方向与外磁场方向垂直、因此磁场力大小为 $F = iB_0 = \frac{(B_2^2 - B_1^2)}{2H}$ 

F的方向垂直子數源平面指向 B. 一號。

 等: 帶电平面國环的旋转相当于國环中通有电流 1. 在 Ki 与 Ki 之间取半径为 R、宽度为 dR 的环带, 环带内有电流 子二学部学生会

$$dI = \sigma R \omega(t) dR$$

d/在限心 O 点处产生的磁场

$$dB = \frac{1}{2} \mu_0 dI/R = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega(t) dR$$

由于整个带电环面旋转,在中心产生的磁感应强度的大小为

$$B = \int_{R_1}^{R_2} dB = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega(t) (R_2 - R_1)$$
 (4 \(\frac{1}{2}\))

选逆时针方向为小环回路的正方向,则小环中

$$\Phi \approx \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega(t) (R_2 - R_1) \pi r^2$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0}{2} \pi r^2 (R_2 - R_1) \sigma \frac{d\omega(t)}{dt}$$

$$i = \frac{\varepsilon_i}{R'} = -\frac{\mu_0 \pi r^2 (R_2 - R_1) \sigma}{2R'} \cdot \frac{d\omega(t)}{dt}$$
(4 \(\frac{\psi}{2}\))

方向: 当 dω(t)/dt>0 时, i 与选定的正方向相反。

(2分)

# 2012级大学物理2期末试题参考答案(信二学习部整理)

4. 解: (1) 由归一化条件 
$$\int_{c}^{c} A^{2} \sin^{2}(\frac{n\pi c}{a})dx = 1$$
, 得  $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$  (2分)

(2) n=1 时, 电子的概率密度

$$P = |\psi(x)|^2 = (2/a)\sin^2(\pi x/a)$$

令  $\frac{dP}{dx} = 0$  , 得概率密度最大的位置,即

$$\frac{4}{a}\sin\frac{\pi x}{a}\cos(\frac{\pi x}{a})\cdot\frac{\pi}{a}=0$$

整理得

$$\sin\frac{2\pi x}{a}=0 \quad \text{if} \quad x=0,\frac{a}{2},a,\frac{3}{2}a,\cdots$$

因为 0 < x < a, 所以 x = a/2。概率最大的位置在 x = a/2 处。

(5分)

(3) n=1 时, 电子在 a/4<x<3a/4 范围内的概率为

$$P = \int_{a/4}^{3o/4} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_{a/4}^{3o/4} \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d(\frac{\pi x}{a})$$
$$= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{\pi x}{2a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]_{a/4}^{3o/4} = \frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right) = 0.818 \tag{3.5}$$

- 5. 答: (1) 物质与反物质碰撞遮灭时,正反物质中蕴函的所有静止质量能以光子的形式完全释放出来。由质能关系式 E = m<sub>0</sub>c', 释放出的能量等于静止质量能,
- 所以这一过程中的释能效率 $\eta = \Delta E/E = 100\%$ 。(2分)
- (2) 利用反证法。取正负电子对的质心作为参照系,在质心系中,正负电子湮灭前动量为零。根据动量守恒,湮灭后的产物总动量一定也为零。如果只产生一个光子,根据相对论的基本假设,光子在任何参照系中光速不变,一个光子不可能具有零动量,与前述质心系中必须具有零动量相矛盾。这就证明了正负电子湮灭不能仅产生一个光子。(3分)